FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a=25°C)					電気的特性 (T_a=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10		11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)													外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} (μA)	最大値 V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
★	2SA537A	日立	RF. SW	Si. EP	−100	− 5	−700	750	200	− 1	−30	30~160	− 4	−50	−10	20		t_{on}=42nS, t_{off}=290nS t_{stg}=240nS			150*	15	30	84B	2SC708A とコンプリ
★	〃 538	東芝	〃	Ge. A	−25	−12	−50	120	75	−50	−25				− 6	1	70				8	10	100	12A	
★	〃 539	日電	PA	Si. E	−60	− 5	−200	250	125	−0.1	−45	80	−1.0	−50	−10	10	80				200*	8.5	20	138	2SC815 とコンプ〃
	〃 540																								
	〃 541																								
★	〃 542	日電	RF. AF	Si. E	−30	− 5	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	− 5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
★	〃 543	〃	RF. LN	〃	−30	− 5	−50	150	150	−0.05	−25	160	−10	−0.5	− 5	1	180	5000	2	28	100*	5	20*	23	
	〃 544	〃	RF. SW	〃	−60	− 5	−200	750	175	−0.1	−45	130	−10	−10	−10	10	100				250*	4	30	84B	2SC32 とコンプリ
★	〃 545	〃	PA	〃	−70	− 5	−200	400	125	−0.1	−45	80	− 1	−50	−10	10	110				200*	8.5	20	44	2SC853 とコンプリ
	〃 546	松下	PA	Si. EP	−70	− 5	−1A	750	175	− 3	−30	80	− 3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696 とコンプリ
	〃 546A	〃	〃	〃	−90	− 5	−1A	750	175	− 3	−30	80	− 3	−100	−10	50					80*	50	20	84B	2SC696A とコンプリ
	〃 547	〃	〃	〃	−70	− 5	−1A	10 W (T_c=25°C)	175	− 3	−30	80	− 3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697 とコンプリ
	〃 547A	〃	〃	〃	−90	− 5	−1A	10 W (T_c=25°C)	175	− 3	−30	80	− 3	−100	−10	50					80*	50	20	97B	2SC697A とコンプリ
★	〃 548	日立	RF. SW	〃	−50	− 5	−100	200	175	− 1	−20	100	−12	− 1	−10	20	t_{on}=90nS, t_{off}=160nS t_{stg}=150nS				400*	4	$C_c \cdot r_{bb'}$ 30pS	8C	
★	〃 549	〃	RF	Si. T	−70	− 5	−100	200	175	− 1	−20	80	− 1	−10	−10	10					200*	2.5	80*	182C	
	〃 550	松下	RF. AF	〃	−25	− 5	−100	300	175	− 1	−10	250	− 5	− 2	− 5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538 とコンプリ
	〃 550A	〃	〃	〃	−45	− 5	−100	300	175	− 1	−10	250	− 5	− 2	− 5	2	150	3000	3	50	120*	5	100	49C	2SC538A とコンプリ
★	〃 551	三洋	〃	Si. EP	−70	− 5	−400	600	150	−10	−70	40~200	− 4	−200	− 4	10					80*				
	〃 552	日電	RF. SW	Si. E	−60	− 5	−200	750	175	−0.1	−45	100	−10	−10	−10	10	100	t_{on}<100nS, t_{off}<300nS t_{stg}<270nS			150*	8	10*	84C	
	〃 553	富士通	RF	Si. EP	−40	− 3	−300	250	175	−0.1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
	〃 554	〃	〃	〃	−25	− 3	−300	250	175	− 1	−10				−10	10	60				200*	4.5	50*	49C	
	〃 555	〃	〃	〃	−50	− 5	−200	200	125	− 1	−10	80	− 1	−10	− 6	2					200*	55	40*	138	
	〃 556	〃	〃	〃	−20		−200	200	125	− 1	−10				−10	10	60				200*	5	50*	30	
★	〃 557	〃	〃	〃	−80	− 6	−600	800	175	− 1	−30	120	− 2	−200							100*	18	20*	84B	
	〃 558	〃	SW	〃	−40	− 5	−200	350	175	−0.1	−10	50	− 1	−10				t_r= 10nS, t_f= 25nS t_s= 90nS			200*	4.5	50*	49C	
	〃 559	〃	〃	〃	−20	− 5	−200	350	175	−0.5	−10	50	− 1	−10				t_r= 10nS, t_f= 25nS t_s= 90nS			200*	4.5	50*	49C	
★	〃 560	東芝 富士通	RF	Si. TP	−80	− 5	−800	800	175	−0.5	−30	30~120	− 2	−150	−10	50	70				150*	11	15	84B	
★	〃 561	東芝	〃	Si. E	−50	− 5	−150	300	125	−0.1	−18	70~400	− 1	−20	− 6	1					70*	13	10	33	2SC734 とコンプリ
★	〃 562	〃	AF.	〃	−35	− 5	−500	500	150	−0.1	−35	70~240	− 1	−100	− 6	20					200	13		138	2SC1959 とコンプリ
	〃 563																								